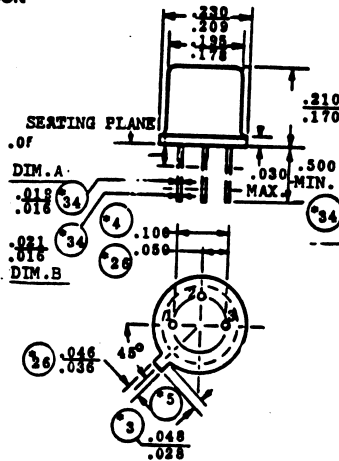


**2N3250,A**  
**2N3251,A**

CASE 22, STYLE 1  
TO-18 (TO-206AA)

GENERAL PURPOSE TRANSISTOR  
PNP SILICON



**MAXIMUM RATINGS**

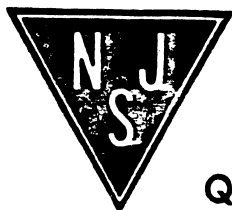
Rating	Symbol	2N3250 2N3251	2N3250A 2N3251A	Unit
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	40	60	Vdc
Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	50	60	Vdc
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	5.0		Vdc
Collector Current	I <sub>C</sub>	200		mAdc
Total Device Dissipation @ T <sub>A</sub> = 25°C Derate above 25°C	P <sub>D</sub>	0.36	2.06	Watt mW/°C
Total Device Dissipation @ T <sub>C</sub> = 25°C Derate above 25°C	P <sub>D</sub>	1.2	6.9	Watts mW/°C
Operating and Storage Temperature Temperature Range	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	-65 to +200		°C

**THERMAL CHARACTERISTICS**

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case	R <sub>θJC</sub>	0.15	mW/°C
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R <sub>θJA</sub>	0.49	mW/°C

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise noted.)**

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
<b>OFF CHARACTERISTICS</b>				
Collector-Emitter Breakdown Voltage (1) (I <sub>C</sub> = 10 mAdc)	V <sub>(BR)CEO</sub>	40 60	—	Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage (I <sub>C</sub> = 10 μAdc)	V <sub>(BR)CBO</sub>	50 60	—	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage (I <sub>E</sub> = 10 μAdc)	V <sub>(BR)EBO</sub>	5.0	—	Vdc
Collector Cutoff Current (V <sub>CE</sub> = 40 Vdc, V <sub>BE</sub> = 3.0 Vdc)	I <sub>CEX</sub>	—	20	Adc
Base Cutoff Current (V <sub>CE</sub> = 40 Vdc, V <sub>BE</sub> = 3.0 Vdc)	I <sub>BL</sub>	—	50	nAdc
<b>ON CHARACTERISTICS</b>				
DC Forward Current Transfer Ratio (1) (I <sub>C</sub> = 0.1 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)	h <sub>FE</sub>	40 80	—	—
(I <sub>C</sub> = 1.0 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)		45 90	—	—
(I <sub>C</sub> = 10 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)		50 100	150 300	—
(I <sub>C</sub> = 50 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)		15 30	—	—
Collector-Emitter Saturation Voltage (1) (I <sub>C</sub> = 10 mAdc, I <sub>B</sub> = 1.0 mAdc) (I <sub>C</sub> = 50 mAdc, I <sub>B</sub> = 5.0 mAdc)	V <sub>CE(sat)</sub>	—	0.25 0.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage (1) (I <sub>C</sub> = 10 mAdc, I <sub>B</sub> = 1.0 mAdc) (I <sub>C</sub> = 50 mAdc, I <sub>B</sub> = 5.0 mAdc)	V <sub>BE(sat)</sub>	0.6 —	0.9 1.2	Vdc
<b>SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS</b>				
Current-Gain — Bandwidth Product (I <sub>C</sub> = 10 mAdc, V <sub>CE</sub> = 20 Vdc, f = 100 MHz)	f <sub>T</sub>	250 300	—	MHz
Output Capacitance (V <sub>CB</sub> = 10 Vdc, I <sub>E</sub> = 0, f = 100 kHz)	C <sub>obo</sub>	—	6.0	pF
Input Capacitance (V <sub>CB</sub> = 1.0 Vdc, I <sub>C</sub> = 0, f = 100 kHz)	C <sub>ibo</sub>	—	8.0	pF





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331